

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ  
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
БИОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ**

## **СТАРТ В НАУКУ**

**МАТЕРИАЛЫ  
LXIX научной студенческой конференции  
Биологического института**

*Томск, 20–24 апреля 2020 г.*

**Томск  
2020**

## **СОЗДАНИЕ ТЕПЛИЧНОГО КОМПЛЕКСА В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

В.С. Пименова  
pimenovavs@tomsk.gov.ru

В целях восстановления вырубленных, погибших, поврежденных лесов необходимо проводить лесовосстановительные мероприятия. Лесовосстановление осуществляется естественным, искусственным или комбинированным способами.

Закладка искусственных насаждений позволяет выращивать видовой состав определенного целевого назначения. Для этого необходимо развивать питомническую базу для выращивания качественного посадочного материала.

С учетом темпа роста заготовки древесины и развития нефтегазового комплекса с обязательствами проводить лесовосстановление посадочным материалом с закрытой корневой системой, в нашем регионе существует острая необходимость создания тепличного комплекса с ежегодным объемом выращивания 10–12 млн. шт.

Планируемый тепличный комплекс будет состоять из 6 теплиц размером 17 м на 80 м и 14 полей закаливания для выращивания посадочного материала с закрытой корневой системой, а также административно-производственного здания.

Предполагается выращивание посадочного материала сосны обыкновенной (70 % от общего объема) и ели сибирской (30 % от общего объема). Для выращивания посадочного материала будут использованы районированные семена. Выращивание семян предполагается в кассетах размером 385 мм на 385 мм, имеющих 121 ячейку. В теплице возможно разместить технологические поддоны с 7124 кассетами. Таким образом, в одной теплице размещается 862000 семян. В этом случае в одну ротацию можно обеспечить выращивание 6 млн. семян. Для достижения стандартных размеров посадочного материала в тепличном комплексе потребуется всего лишь 1 год (1 ротация). Производство такого посадочного материала почти полностью автоматизированное.

Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент Н.В. Пинаева